

New Jersey Semi-Conductor Products, Inc.

20 STERN AVE.
SPRINGFIELD, NEW JERSEY 07081
U.S.A.

2N6342A (SILICON)

thru

2N6349A

TELEPHONE: (201) 376-2922
(212) 227-6005
FAX: (201) 376-8960

SILICON BIDIRECTIONAL THYRISTORS

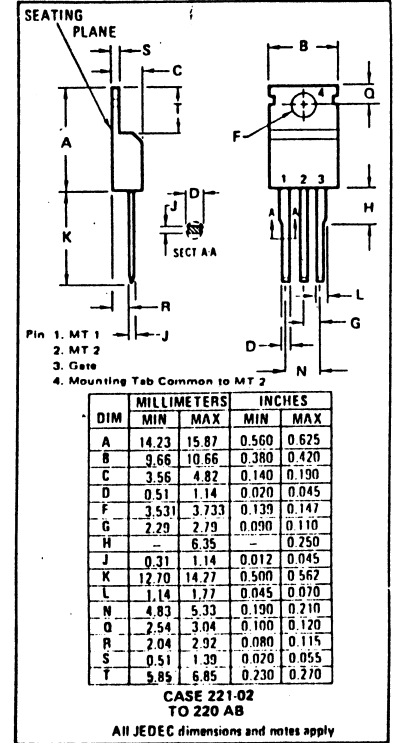
MAXIMUM RATINGS

Rating	Symbol	Value	Unit
*Repetitive Peak Off-State Voltage, Note 1 ($T_J = -40$ to $+110^\circ\text{C}$) ½ Sine Wave 50 to 60 Hz, Gate Open	V_{DRM}	200 400 600 800	Volts
*Peak Gate Voltage	V_{GM}	10	Volts
*On-State Current RMS ($T_C = +80^\circ\text{C}$) Full Cycle Sine Wave 50 to 60 Hz ($T_C = +95^\circ\text{C}$)	$I_T(\text{RMS})$	12 6.0	Amp
*Peak Surge Current (One Full Cycle, 60 Hz, $T_C = +80^\circ\text{C}$) preceded and followed by rated current	I_{TSM}	120	Amp
Circuit Fusing Considerations ($T_J = -40$ to $+110^\circ\text{C}$, $t = 1.0$ to 8.3 ms)	I^2t	40	A^2s
*Peak Gate Power ($T_C = +80^\circ\text{C}$, Pulse Width = $2.0 \mu\text{s}$)	P_{GM}	20	Watts
*Average Gate Power ($T_C = +80^\circ\text{C}$, $t = 8.3$ ms)	$P_{G(AV)}$	0.5	Watt
*Peak Gate Current	I_{GM}	2.0	Amp
*Operating Junction Temperature Range	T_J	-40 to +110	$^\circ\text{C}$
*Storage Temperature Range	T_{stg}	-40 to +150	$^\circ\text{C}$

THERMAL CHARACTERISTIC

Characteristic	Symbol	Max	Unit
*Thermal Resistance, Junction to Case	$R_{\theta JC}$	2.0	$^\circ\text{C}/\text{W}$

*Indicates JEDEC Registered Data.



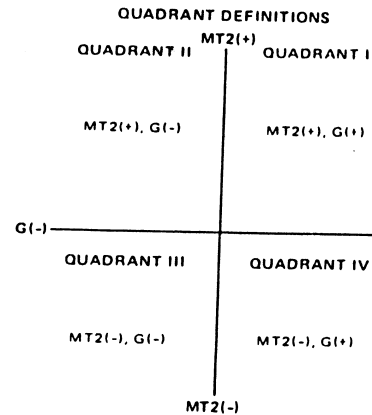
ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_C = 25^\circ$ unless otherwise noted)

Characteristic	Symbol	Min	Typ	Max	Unit
*Peak Blocking Current (Either Direction) Rated V_{DRM} @ $T_J = 110^\circ\text{C}$, Gate Open	I_{DRM}	—	—	2.0	mA
*Peak On-State Voltage (Either Direction) $I_{TM} = 17$ A Peak; Pulse Width = 1.0 to 2.0 ms, Duty Cycle $\leq 2.0\%$	V_{TM}	—	1.3	1.75	Volts
Peak Gate Trigger Current Main Terminal Voltage = 12 Vdc, $R_L = 100$ Ohms Minimum Gate Pulse Width = $2.0 \mu\text{s}$	I_{GTM}				mA
MT2 (+), G(+) All Types	—	6.0	50		
MT2 (+), G(-) 2N6346A thru 2N6349A	—	6.0	75		
MT2 (-), G(-) All Types	—	10	50		
MT2 (-), G(+) 2N6346A thru 2N6349A	—	25	75		
*MT2 (+), G(+); MT2 (-), G(-) $T_C = -40^\circ\text{C}$ All Types	—	—	—	100	
*MT2 (+), G(-); MT2 (-), G(+) $T_C = -40^\circ\text{C}$ 2N6346A thru 2N6349A	—	—	—	125	
Peak Gate Trigger Voltage Main Terminal Voltage = 12 Vdc, $R_L = 100$ Ohms Minimum Gate Pulse Width = $2.0 \mu\text{s}$	V_{GTM}				Volts
MT2 (+), G(+) All Types	—	0.9	2.0		
MT2 (+), G(-) 2N6346A thru 2N6349A	—	0.9	2.5		
MT2 (-), G(-) All Types	—	1.1	2.0		
MT2 (-), G(+) 2N6346A thru 2N6349A	—	1.4	2.5		
*MT2 (+), G(+); MT2 (-), G(-) $T_C = -40^\circ\text{C}$ All Types	—	—	—	2.5	
*MT2 (+), G(-); MT2 (-), G(+) $T_C = -40^\circ\text{C}$ 2N6346A thru 2N6349A	—	—	—	3.0	
Main Terminal Voltage = Rated V_{DRM} , $R_L = 10$ k ohms, $T_J = 110^\circ\text{C}$					
*MT2 (+), G(+); MT2 (-), G(-) All Types	0.2	—	—		
*MT2 (+), G(-); MT2 (-), G(+) 2N6346A thru 2N6349A	0.2	—	—		
Holding Current (Either Direction) Main Terminal Voltage = 12 Vdc, Gate Open, Initiating Current = 200 mA	I_H	—	6.0	40	mA
$T_C = 25^\circ\text{C}$		—	—	75*	
$T_C = -40^\circ\text{C}$					
*Turn-On Time Rated V_{DRM} , $I_{TM} = 17$ A $I_{GT} = 120$ mA, Rise Time = $0.1 \mu\text{s}$, Pulse Width = $2.0 \mu\text{s}$	t_{gt}	—	1.5	2.0	μs
Critical Rate of Rise of Commutation Voltage Rated V_{DRM} , $I_{TM} = 17$ A, Commutating $di/dt = 6.5$ A/ms, Gate Unenergized $T_C = 80^\circ\text{C}$	dv/dt	—	5.0	—	V/ μs

*Indicates JEDEC Registered Data

NOTES:

- Ratings apply for open gate conditions. Thyristor devices shall not be tested with a constant current source for blocking capability such that the voltage applied exceeds the rated blocking voltage.



О компании

ООО "ТрейдЭлектроникс" - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Наличие собственной эффективной системы логистики обеспечивает надежную поставку продукции по конкурентным ценам в точно указанные сроки.

Срок поставки со стоков в **Европе и Америке – от 3 до 14 дней.**

Срок поставки из **Азии – от 10 дней.**

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Предоставляем спец цены на элементы для создания инженерных сэмплов.

Упорный труд, качественный результат дают нам право быть уверенными в себе и надежными для наших клиентов.

Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование

Наша организация особенно сильна в поставках модулей, микросхем, пассивных компонентов, ксайленсах (XC), EPF, EPM и силовой электроники.

Большой выбор предлагаемой продукции, различные виды оплаты и доставки, позволят Вам сэкономить время и получить максимум выгоды от сотрудничества с нами!

Перечень производителей, продукцию которых мы поставляем на российский рынок



С удовольствием будем прорабатывать для Вас поставки всех необходимых компонентов по текущим запросам для скорейшего выявления групп элементов, по которым сотрудничество именно с нашей компанией будет для Вас максимально выгодным!

С уважением,

Менеджер отдела продаж ООО

«Трейд Электроникс»

Шишлаков Евгений

8 (495)668-30-28 доб 169

manager28@tradeelectronics.ru

<http://www.tradeelectronics.ru/>